

**Физика и техника полупроводников,  
2018, том 52, выпуск 12**

К столетию со дня рождения профессора С. М. Рывкина (1918-1981)

1399

**XXII Международный симпозиум "Нанозлектроника и нанозлектроника", Нижний Новгород, 12-15 марта 2018 г.**

Акимов А.Н., Климов А.Э., Эпов В.С.

**XXII Международный симпозиум Нанозлектроника и нанозлектроника", Нижний Новгород, 12-15 марта 2018 г. Эффект поля в пленках PbSnTe : In с низкой проводимостью в режиме инжекции из контактов и ограничения тока пространственным зарядом**

1401

Мансуров В.Г., Галицын Ю. Г., Малин Т.В., Тийс С.А., Федосенко Е.В., Кожухов А.С., Журавлев К.С., Cora Ildiko, Pecz Bela

**Формирование графеноподобного слоя SiN на поверхности (111)Si**

1407

Венедиктов М.М., Тарасова Е.А., Боженькина А.Д., Оболенский С.В., Елесин В.В., Чуков Г.В., Метелкин И.О., Кревский М.А., Дюков Д.И., Фелелов А.Г.

**Анализ поведения неравновесных полупроводниковых структур и СВЧ транзисторов в момент и после импульсного гамма- и гамма-нейтронного облучения**

1414

Горшков А.П., Волкова Н.С., Павлов Д.А., Усов Ю.В., Истомин Л.А., Левичев С.Б.

**Связь электронных свойств квантовых точек InAs/GaAs, выращенных газовой эпитаксией, с их структурой**

1421

Мизеров А.М., Тимошнев С.Н., Соболев М.С., Никитина Е.В., Шубина К.Ю., Березовская Т.Н., Штром И.В., Буравлев А.Д.

**Особенности начальных стадий роста GaN на подложках Si(111) при молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота**

1425

Полищук О.В., Фатеев Д.В., Попов В.В.

**Электрическая перестройка усиления терагерцового излучения в периодической плазменной графеновой структуре с инжекцией носителей заряда**

1430

Тихов С.В., Горшков О.Н., Антонов И.Н., Тетельбаум Д.И., Михайлов А.Н., Белов А.И., Морозов А.И., Karakolis P., Dimitrakis P.

**Особенности поведения МДП мемристоров с нанослоем Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, изготовленных на основе проводящей подложки Si**

1436

Байдусь Н.В., Алешкин В.Я., Дубинов А.А., Красильник З.Ф., Кудрявцев К.Е., Некоркин С.М., Новиков А.В., Рыков А.В., Реунов Д.Г., Шалеев М.В., Юнин П.А., Юрасов Д.В.

**Применение компенсирующих слоев GaAsP для роста лазерных гетероструктур с квантовыми ямами InGaAs/GaAs, излучающих на длинах волн больше 1100 нм, на искусственных подложках Ge/Si**

1443

Гудина С.В., Арапов Ю.Г., Ильченко Е.В., Неверов В.Н., Савельев А.П., Подгорных С.М., Шелушнина Н.Г., Якунин М.В., Васильевский И.С., Виниченко А.Н.

**Неуниверсальное скейлинговое поведение ширины пиков проводимости в режиме квантового эффекта Холла в структурах InGaAs/InAlAs**

1447

Ерофеева И.В., Дорохин М.В., Здоровейщев А.В., Кузнецов Ю.М., Попов А.А., Ланцев Е.А., Боряков А.В., Котомина В.Е.

**Получение электроимпульсным плазменным спеканием термоэлектрических материалов на основе Si и Ge**

1455

Самарцев И.В., Некоркин С.М., Звонков Б.Н., Алешкин В.Я., Дубинов А.А., Пашенькин И.Ю., Дикарева Н.В., Чигинева А.Б.

**Фотоприемники с активной областью InGaAs и метаморфным буферным слоем InGaP, выращенные на подложках GaAs**

1460

Сибирев Н.В., Котляр К.П., Корякин А.А., Штром И.В., Убийвовк Е.В., Сошников И.П., Резник Р.Р., Буравлев А.Д., Цырлин Г.Э.

**Солнечный элемент на основе нитевидных нанокристаллов с радиальным гетеропереходом**

1464

Цыпленков В.В., Шастин В.Н.

**Внутрицентровая релаксация мелких доноров мышьяка в деформированном германии. Инверсия населенностей при оптическом возбуждении**

Сабликов В.А., Ткач Ю.Я. <b>Сингулярность плотности состояний и анизотропия транспорта в двумерном электронном газе со спин-орбитальным взаимодействием в параллельном магнитном поле</b>	1469
Спирин К.Е., Гапонова Д.М., Маремьянин К.В., Румянцев В.В., Гавриленко В.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А. <b>Биполярная остаточная фотопроводимость в гетероструктурах HgTe/CdHgTe (013) с двойными квантовыми ямами</b>	1477
Маремьянин К.В., Иконников А.В., Бовкун Л.С., Румянцев В.В., Чижевский Е.Г., Засавицкий И.И., Гавриленко В.И. <b>Терагерцовые инжекционные лазеры на основе твердого раствора PbSnSe с длиной волны излучения до 50 мкм и их использование для магнитоспектроскопии полупроводников</b>	1482
<b>Публикация материалов Симпозиума завершена.</b>	
<b>Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления</b> Шашкин И.С., Соболева О.С., Гаврина П.С., Золотарев В.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. <b>Полностью электрическое управление разверткой лазерного луча на основе квантово-размерной гетероструктуры с интегрированным распределенным брэгговским зеркалом</b>	1486
Мамутин В.В., Ильинская Н.Д., Усикова А.А., Лютецкий А.В. <b>Полосковая структура для изорешеточных квантовых каскадных лазеров</b>	1491
<b>Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники</b> Фефелов С.А., Казакова Л.П., Богословский Н.А., Цэндин К.Д. <b>Оценка температуры шнура тока, возникающего при переключении в халькогенидах системы GeSbTe</b>	1499
<b>Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники</b> Алексеев П.А., Дунаевский М.С., Михайлов А.О., Лебедев С.П., Лебедев А.А., Илькив И.В., Хребтов А.И., Буравлев А.Д., Цырлин Г.Э. <b>Электрические свойства GaAs нитевидных нанокристаллов, выращенных на гибридных подложках графен/SiC</b>	1503
<b>Углеродные системы</b> Агринская Н.В., Лебедев А.А., Лебедев С.П., Шахов М.А., Lahderanta E. <b>Переход между электронной локализацией и антилокализацией, а также проявление фазы Берри в графене на поверхности SiC</b>	1507
<b>Физика полупроводниковых приборов</b> Асрян Л.В., Зубов Ф.И., Балезина (Полубавкина) Ю.С., Моисеев Э.И., Муретова М.Е., Крыжановская Н.В., Максимов М.В., Жуков А.Е. <b>Нарушение локальной электронейтральности в квантовой яме полупроводникового лазера с асимметричными барьерными слоями</b>	1512
Иванов П.А., Самсонова Т.П., Потапов А.С. <b>Устойчивость высоковольтных (1430 В) 4H-SiC p<sup>+</sup>-n<sub>0</sub>-n<sup>+</sup>-диодов к лавинному пробое</b>	1518
Козловский В.В., Лебедев А.А., Давыдовская К.С., Любимова Ю.В. <b>Гальванические и емкостные эффекты при компенсации проводимости n-SiC радиационными дефектами</b>	1527
<b>Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур</b> Ильин А.С., Мацукатова А.Н., Форш П.А., Vygranenko Yu. <b>Электрические свойства тонких пленок оксида индия, полученных методом плазменно-термического испарения</b>	1532
	1535